

(19)대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。 Int. Cl.	(45) 공고일자	2006년10월18일
H05B 33/04 (2006.01)	(11) 등록번호	10-0635514
H05B 33/10 (2006.01)	(24) 등록일자	2006년10월11일

(21) 출원번호	10-2006-0007025	(65) 공개번호
(22) 출원일자	2006년01월23일	(43) 공개일자

(73) 특허권자	삼성에스디아이 주식회사 경기 수원시 영통구 신동 575
(72) 발명자	최동수 경기 용인시 기흥읍 공세리 삼성SDI중앙연구소 박진우 경기 용인시 기흥읍 공세리 삼성SDI중앙연구소
(74) 대리인	박상수

(56) 선행기술조사문헌	
JP11329717 A	KR102003001572 A
KR1020030094003 A	KR1020040010370 A
* 심사관에 의하여 인용된 문헌	

심사관 : 정두한

(54) 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법

요약

본 발명은 기관을 봉지하는 글라스 프리트에 레이저를 조사하는데 있어서, 레이저의 고열에 의한 소자의 손상을 방지할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명은 반도체층, 게이트 전극 및 소스/드레인 전극을 포함하는 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터 상에 위치하는 유기평탄화막; 상기 유기평탄화막 상에 위치하는 제 1 전극; 상기 제 1 전극 상에 위치하는 화소정의막; 상기 제 1 전극 및 화소정의막 상에 위치하며, 적어도 발광층을 포함하는 유기막층; 상기 유기막층 상에 위치하는 제 2 전극;을 포함하는 화소영역 및 화소영역 이외의 영역인 비화소영역을 구비하는 기관; 및 상기 기관을 봉지하는 봉지기판을 포함하며, 상기 비화소영역은 메탈 배선; 상기 메탈 배선의 일부분을 노출시키는 개구부를 포함하는 유기평탄화막; 및 상기 개구부 상에 위치하며, 상기 기관과 상기 봉지기판을 봉지하기 위한 글라스 프리트;을 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 5

색인어

글라스 프리트, 유기전계발광표시장치

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 유기전계발광표시장치의 단면도.

도 2 내지 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 단면도.

<도면 주요부호에 대한 부호의 설명>

300 : 기관 310 : 버퍼층

320 : 반도체층 330 : 게이트 절연막

340a : 게이트 전극 340b : 스캔드라이버

350 : 층간 절연막 360a, 360b : 소스/드레인 전극

360c : 제 2 전극 전원공급라인 360d : 메탈 배선

370 : 평탄화막 375 : 반사막

380 : 제 1 전극 390 : 화소정의막

400 : 유기막층 410 : 제 2 전극

420 : 봉지기판 430 : 글라스 프리트

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 기관을 봉지하는 글라스 프리트에 레이저를 조사하는데 있어서, 레이저의 고열에 의한 소자의 손상을 방지할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

최근에 음극선관(cathode ray tube)과 같은 종래의 표시소자의 단점을 해결하는 액정표시장치(liquid crystal display device), 유기전계발광장치(organic electroluminescence device) 또는 PDP(plasma display panel)등과 같은 평판형 표시장치(flat panel display device)가 주목받고 있다.

상기 액정표시장치는 자체발광소자가 아니라 수광소자이기 때문에 밝기, 콘트라스트, 시야각 및 대면적화 등에 한계가 있고, PDP는 자체발광소자이지만, 다른 평판형표시장치에 비해 무게가 무겁고, 소비전력이 높을 뿐만 아니라 제조방법이 복잡하다는 문제점이 있다.

반면에, 유기전계발광표시장치는 자체발광소자이기 때문에 시야각, 콘트라스트 등이 우수하고, 백라이트가 필요하지 않기 때문에 경량, 박형이 가능하고, 소비 전력 측면에서도 유리하다. 또한, 직류 저전압 구동이 가능하고 응답속도가 빠르며 전부 고체이기 때문에 외부 충격에 강하고 사용 온도 범위도 넓을 뿐만 아니라 제조 방법이 단순하고 저렴하다는 장점을 가지고 있다.

도 1은 종래 유기전계발광표시장치의 단면도이다.

도 1을 참조하면, 화소영역(I)과 비화소영역(II)이 구비된 기판(100) 상에 반도체층(110), 게이트 절연막(120), 게이트 전극(130a), 스캔드라이버(130b), 층간 절연막(140) 및 소스/드레인 전극(150)이 구비되고, 소스/드레인 배선으로 이루어진 공통전원공급라인(150b), 제 2 전극 전원공급라인(150a)이 구비된다.

상기 기판(100) 전면에 평탄화막(160)이 구비된다. 상기 평탄화막(160)은 유기물로 아크릴계 수지 또는 폴리이미드계 수지로 이루어진다.

상기 평탄화막(160)은 상기 공통전원공급라인(150b), 제 2 전극 전원공급라인(150a) 및 소스/드레인 전극(150)을 노출시키는 비어홀들이 구비된다. 상기 공통전원공급라인(150b)을 노출시키는 이유는 추후 기판을 글라스 프리트(220)로 봉지할 때, 접착력을 좋게 하기 위함이다.

상기 기판(100) 상에 반사막(170)을 포함하는 제 1 전극(171)이 구비되고, 상기 기판(100) 전면에 화소정의막(180)이 구비된다.

상기 제 1 전극(171) 상에 적어도 발광층을 포함하는 유기막층(190)이 구비되고, 그 상부에 제 2 전극(200)이 구비된다. 상기 기판(100)에 대향하는 봉지기판(210)이 제공되고, 상기 기판(100)과 봉지기판(210)은 글라스 프리트(220)으로 봉지되어 종래 기술에 따른 유기전계발광표시장치가 구성된다.

그러나, 종래의 유기전계발광표시장치는 기판을 봉지하는 글라스 프리트의 하부에 소스/드레인 배선인 공통전원공급라인이 위치하게 되는데, 상기 공통전원공급라인의 폭이 상기 글라스 프리트의 폭보다 넓어서 글라스 프리트에 레이저 조사시, 상기 공통전원공급라인에도 조사되어 레이저의 고열이 상기 제 2 전원공급라인으로 전달되고 이는 제 2 전극을 타고 소자 내부로 전달되어 유기막층이 손상된다. 이로써, 상기 소자의 신뢰성이 저하되는 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 제반단점과 문제점을 해결하기 위한 것으로, 기판을 봉지하는 글라스 프리트에 레이저를 조사하는데 있어서, 상기 레이저의 고열에 의한 소자의 손상을 방지할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법을 제공함에 본 발명의 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 상기 목적은 반도체층, 게이트 전극 및 소스/드레인 전극을 포함하는 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터 상에 위치하는 유기평탄화막; 상기 유기평탄화막 상에 위치하는 제 1 전극; 상기 제 1 전극 상에 위치하는 화소정의막; 상기 제 1 전극 및 화소정의막 상에 위치하며, 적어도 발광층을 포함하는 유기막층; 상기 유기막층 상에 위치하는 제 2 전극;을 포함하는 화소영역 및 화소영역 이외의 영역인 비화소영역을 구비하는 기판; 및 상기 기판을 봉지하는 봉지기판을 포함하며, 상기 비화소영역은 메탈 배선; 상기 메탈 배선의 일부분을 노출시키는 개구부를 포함하는 유기평탄화막; 및 상기 개구부 상에 위치하며, 상기 기판과 상기 봉지기판을 봉지하기 위한 글라스 프리트;을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치에 의해 달성된다.

또한, 본 발명의 상기 목적은 화소영역과 비화소영역을 포함하는 기판을 제공하는 단계; 상기 화소영역의 기판 상에 반도체층, 게이트 전극 및 소스/드레인 전극을 포함하는 박막 트랜지스터 및 상기 비화소영역의 기판 상에 메탈배선을 형성하는 단계; 상기 기판 전면에 유기평탄화막을 형성하는 단계; 상기 비화소영역의 유기평탄화막을 식각하여 상기 메탈배선의 일부영역을 노출시키는 단계; 상기 화소영역의 유기평탄화막 상에 제 1 전극을 형성하는 단계; 상기 기판 전면에 화소정의막을 형성하는 단계; 상기 비화소영역의 메탈배선상의 화소정의막을 식각하는 단계; 상기 화소영역의 제 1 전극 및 화소정의막 상에 적어도 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하는 단계; 상기 기판 전면에 제 2 전극을 형성하는 단계; 상기 비화소영역의 메탈배선상의 제 2 전극을 식각하는 단계; 봉지기판을 제공하는 단계; 상기 봉지기판의 외측에 글라스 프리트를 도포하여 상기 기판과 봉지하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법에 의해 달성된다.

본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 바람직한 실시예를 도시하고 있는 도면을 참조한 이하 상세한 설명에 의해 보다 명확하게 이해될 것이다. 또한 도면들에 있어서, 층 및 영역의 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

도 2 내지 도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 단면도이다.

도 2를 참조하면, 화소영역(I)과 비화소영역(II)을 구비하는 기관(300)을 제공한다. 상기 기관(300)은 절연 유리, 플라스틱 또는 도전성 기관을 사용할 수 있다.

이어서, 상기 기관(300) 전면에 버퍼층(310)을 형성한다. 상기 버퍼층(310)은 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 이들의 다중층일 수 있다. 또한, 상기 버퍼층(310)은 하부의 기관에서 불순물이 상부로 올라오지 못하도록 방지하는 보호막의 역할을 한다.

이어서, 상기 화소영역(I)의 상기 버퍼층(310) 상에 반도체층(320)을 형성한다. 상기 반도체층(320)은 비정질 실리콘막 또는 이를 결정화한 다결정 실리콘막일 수 있다. 이어 상기 기관(300) 전면에 게이트 절연막(330)을 형성한다. 상기 게이트 절연막(330)은 실리콘 산화막, 실리콘 질화막 또는 이들의 다중층일 수 있다.

이후에, 상기 게이트 절연막(330) 상에 상기 반도체층(320)의 일부 영역과 대응되게 게이트 전극(340a)을 형성한다. 상기 게이트 전극(340a)은 Al, Cu 또는 Cr을 사용할 수 있다.

이어서, 상기 기관(300) 전면에 층간 절연막(350)을 형성한다. 상기 층간 절연막(350)은 실리콘산화막, 실리콘질화막 또는 이들의 다중층일 수 있다. 상기 화소영역(I) 상의 상기 층간 절연막(350) 및 게이트 절연막(330)을 식각하여 상기 반도체층(320)을 노출시키는 콘택홀(351,352)을 형성한다.

이어서, 상기 화소영역(I) 상의 층간 절연막(350) 상에 소스/드레인 전극(360a,360b)을 형성한다. 상기 소스/드레인 전극(360a,360b)은 Mo, Cr, Al, Ti, Au, Pd 또는 Ag로 이루어진 군에서 선택된 하나를 사용할 수 있다. 또한, 상기 소스/드레인 전극(360a,360b)은 상기 콘택홀(351,352)을 통해 상기 반도체층(120)과 연결된다.

또한, 상기 소스/드레인 전극(360a,360b)을 형성할 때, 상기 비화소영역(II) 상에 메탈 배선(360d)이 동시에 형성되고, 상기 메탈 배선(360d)은 공통전원공급라인으로 작용할 수 있다. 또한, 제 2 전극 전원공급라인(360c)도 형성될 수 있다.

또한, 상기 게이트 전극(340a)을 형성할 때, 상기 비화소영역(II) 상에 스캔 드라이버(340b)가 동시에 형성될 수 있다.

이때, 상기 소스/드레인 전극(360a,360b) 및 메탈 배선(360d)을 형성할 때, 상기 비화소영역(II)에 위치하는 상기 메탈 배선(360d)은 추후 형성되는 글라스 프리트의 폭보다 좁게 형성된다. 일반적으로 상기 글라스 프리트의 폭은 0.7mm정도로 형성되지만, 소자의 규격에 따라 달라지므로 상기 메탈 배선(360d)의 폭의 수치는 한정되지 않고, 상기 글라스 프리트의 폭보다 좁게 형성하는 것이 바람직하다. 이는 추후 기관을 봉지하는 글라스 프리트의 하부에 메탈 배선이 위치하게 되는데, 상기 메탈 배선의 폭이 상기 글라스 프리트의 폭보다 넓으면, 글라스 프리트에 레이저 조사시, 상기 공통전원공급라인으로 작용하는 메탈 배선에도 조사되어 레이저의 고열이 상기 제 2 전극 전원공급라인으로 전달되고 이는 제 2 전극을 타고 소자 내부로 전달되어 유기막층이 손상되는 단점을 방지하기 위함이다.

본 발명에서는 탑(top) 게이트 구조의 박막 트랜지스터를 형성하였지만, 이와는 달리, 게이트 전극이 반도체층 하부에 위치하는 바텀(bottom) 게이트 구조로 형성할 수도 있다.

또한, 본 발명에서는 소스/드레인 전극을 형성할 때, 동시에 메탈 배선을 형성하였지만, 이와는 달리, 게이트 전극 또는 제 1 전극을 형성할 때, 메탈 배선을 동시에 형성할 수도 있다.

이어서, 도 3을 참조하면, 상기 기관(300) 전면에 평탄화막(370)을 형성한다. 상기 평탄화막(370)은 유기막 또는 무기막으로 형성하거나 이들의 복합막으로 형성할 수 있다. 상기 평탄화막(370)을 무기막으로 형성하는 경우는 SOG(spin on glass)를 사용하여 형성하는 것이 바람직하고, 유기막으로 형성하는 경우 아크릴계 수지, 폴리이미드계 수지 또는 BCB(benzocyclobutene)을 사용하여 형성하는 것이 바람직하다.

이때, 상기 화소영역(I)의 평탄화막(370)을 식각하여 상기 소스/드레인 전극 중 어느 하나를 노출시키는 비어홀(371a)을 형성하고, 상기 비화소영역(II)의 평탄화막(370)을 식각하여 상기 메탈 배선(360d)과 상기 제 2 전극 전원공급라인(360c)을 노출시키는 개구부(371b, 371c)를 형성한다. 상기 메탈 배선(360d)을 노출시키는 것은 추후 글라스 프리트로 봉지되었을 때, 기판과의 접착력을 더욱 향상시키기 위함이다.

이어서, 도 4를 참조하면, 상기 화소영역(I)의 평탄화막(370) 상에 반사막(375)을 포함하는 제 1 전극(380)을 형성한다. 상기 제 1 전극(380)은 상기 비어홀(371)의 바닥에 위치하여 상기 노출된 소스/드레인 전극(360a, 360b) 중 어느 하나에 접하고, 상기 평탄화막(370) 상으로 연장된다. 상기 제 1 전극(380)은 ITO(Indium Tin Oxide) 또는 IZO(Indium Zinc Oxide)를 사용할 수 있다.

이어서, 상기 제 1 전극(380)을 포함한 기판(300) 전면에서 화소정의막(390)을 형성하되, 상기 제 1 전극(380)이 위치한 비어홀(371a)을 충분히 채울 수 있을 정도의 두께로 형성한다. 상기 화소정의막(390)은 유기막 또는 무기막으로 형성할 수 있으나, 바람직하게는 유기막으로 형성한다. 더욱 바람직하게는 상기 화소정의막(390)은 BCB(benzocyclobutene), 아크릴계 고분자 및 폴리이미드로 이루어진 군에서 선택되는 하나이다. 상기 화소정의막은 유동성(flowability)이 뛰어나므로 상기 기판 전체에 평탄하게 형성할 수 있다.

이때, 상기 화소영역(I)의 화소정의막(390)을 식각하여 상기 제 1 전극(380)을 노출시키는 개구부(395a)를 형성하고, 상기 비화소영역(II)의 제 2 전극 전원공급라인(360c)을 노출시키는 개구부(395b)를 형성한다.

또한, 상기 비화소영역(II)의 메탈 배선(360d) 상부에도 상기 화소정의막(390)이 존재하지 않도록 식각한다.

이어서, 상기 개구부(395)를 통해 노출된 제 1 전극(380) 상에 유기막층(400)을 형성한다. 상기 유기막층(400)은 적어도 발광층을 포함하며, 정공주입층, 정공수송층, 전자수송층 또는 전자주입층 중 어느 하나 이상의 층을 추가로 포함할 수 있다.

이어서, 상기 기판(300) 전면에서 제 2 전극(410)을 형성한다. 상기 제 2 전극(410)은 투과전극으로 투명하면서 일함수가 낮은 Mg, Ag, Al, Ca 및 이들의 합금으로 사용할 수 있다. 이때, 상기 비화소영역(II)의 제 2 전극(410)을 식각하여 상기 메탈 배선(360d) 및 평탄화막(370)을 노출시킨다.

다음에, 도 5를 참조하면, 상기 기판(300)에 대향하는 봉지기판(420)을 제공한다. 상기 봉지기판(420)은 에칭된 절연유리 또는 에칭되지 않은 절연유리를 사용할 수 있다.

이어서, 상기 봉지기판(420)의 외측에 글라스 프리트(430)을 형성한다. 즉 기판에 대향하는 봉지기판 외측에 글라스 프리트(430)을 도포한다.

상기 글라스 프리트(430)은 산화납(PbO), 삼산화이붕소(B₂O₃) 및 이산화규소(SiO₂)로 이루어진 군에서 선택된 하나를 사용할 수 있으며, 디스펜싱(dispensing)법 또는 스크린 인쇄법을 사용하여 도포할 수 있다.

본 실시 예에서는 상기 봉지기판(420) 상에 글라스 프리트(430)을 형성하였지만, 상기 기판(300) 상에 형성할 수도 있다.

이어서, 상기 기판(300)과 봉지기판(420)을 열라인한 후, 합착한다. 이때, 상기 글라스 프리트(430)은 상기 기판(300) 상의 메탈 배선(360d) 및 평탄화막(370)에 접촉하게 된다.

다음에, 상기 글라스 프리트(430)에 레이저를 조사하여 상기 글라스 프리트(430)을 용융하고, 고상화하여 상기 기판 및 봉지기판에 접착되도록 하여 본 발명의 유기전계발광표시장치를 완성한다.

상기와 같이, 기판 외측에 위치하며, 추후 글라스 프리트와 접촉하는 메탈 배선의 폭을 상기 글라스 프리트의 폭보다 좁게 형성하여, 종래 상기 글라스 프리트에 레이저를 조사할 때, 열이 소자 내부로 전달되어 소자의 신뢰성을 저하시키는 단점을 방지할 수 있는 이점이 있다.

본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시 예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.

발명의 효과

따라서, 본 발명의 유기전계발광표시장치 및 그 제조방법은 기판을 봉지하는 글라스 프리트에 레이저를 조사하는데 있어서, 상기 레이저의 고열에 의한 소자의 손상을 방지할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

반도체층, 게이트 전극 및 소스/드레인 전극을 포함하는 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터 상에 위치하는 평탄화막;

상기 평탄화막 상에 위치하는 제 1 전극;

상기 제 1 전극 상에 위치하는 화소정의막;

상기 제 1 전극 및 화소정의막 상에 위치하며, 적어도 발광층을 포함하는 유기막층;

상기 유기막층 상에 위치하는 제 2 전극;을 포함하는 화소영역 및 화소영역 이외의 영역인 비화소영역을 구비하는 기판; 및

상기 기판을 봉지하는 봉지기판을 포함하며,

상기 비화소영역은 메탈 배선;

상기 메탈 배선의 일부분을 노출시키는 개구부를 포함하는 평탄화막; 및

상기 개구부 상에 위치하며, 상기 기판과 상기 봉지기판을 봉지하기 위한 글라스 프리트를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 메탈 배선은 상기 글라스 프리트의 폭보다 좁은 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 글라스 프리트는 산화납(PbO), 삼산화이붕소(B₂O₃) 및 이산화규소(SiO₂)로 이루어진 군에서 선택된 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 글라스 프린트는 상기 기관의 외측에 위치하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 메탈 배선은 게이트 전극, 소스/드레인 전극 또는 제 1 전극물질 중 어느 하나로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 메탈 배선은 공통전원공급라인인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 7.

제 1 항에 있어서,

상기 비화소영역은 제 2 전극 전원공급라인 및 스캔 드라이버를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 8.

화소영역과 비화소영역을 포함하는 기관을 제공하는 단계;

상기 화소영역의 기관 상에 반도체층, 게이트 전극 및 소스/드레인 전극을 포함하는 박막 트랜지스터 및 상기 비화소영역의 기관 상에 메탈배선을 형성하는 단계;

상기 기관 전면에 평탄화막을 형성하는 단계;

상기 비화소영역의 평탄화막을 식각하여 상기 메탈배선의 일부영역을 노출시키는 단계;

상기 화소영역의 평탄화막 상에 제 1 전극을 형성하는 단계;

상기 기관 전면에 화소정의막을 형성하는 단계;

상기 비화소영역의 메탈배선상의 화소정의막을 식각하는 단계;

상기 화소영역의 제 1 전극 및 화소정의막 상에 적어도 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하는 단계;

상기 기관 전면에 제 2 전극을 형성하는 단계;

상기 비화소영역의 메탈배선상의 제 2 전극을 식각하는 단계;

봉지기판을 제공하는 단계;

상기 봉지기판의 외측에 글라스 프린트를 도포하여 상기 기관과 봉지하는 단계;

상기 글라스 프리트에 레이저를 조사하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 9.

제 8 항에 있어서,

상기 메탈배선은 상기 게이트 전극 또는 제 1 전극을 형성할 때, 동시에 형성되는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 10.

제 8 항에 있어서,

상기 메탈배선은 상기 글라스 프리트의 폭보다 좁게 패터닝하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

청구항 11.

제 8 항에 있어서,

상기 기판을 봉지하는 단계는

상기 글라스 프리트가 상기 메탈 배선 및 평탄화막 상에 접착되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

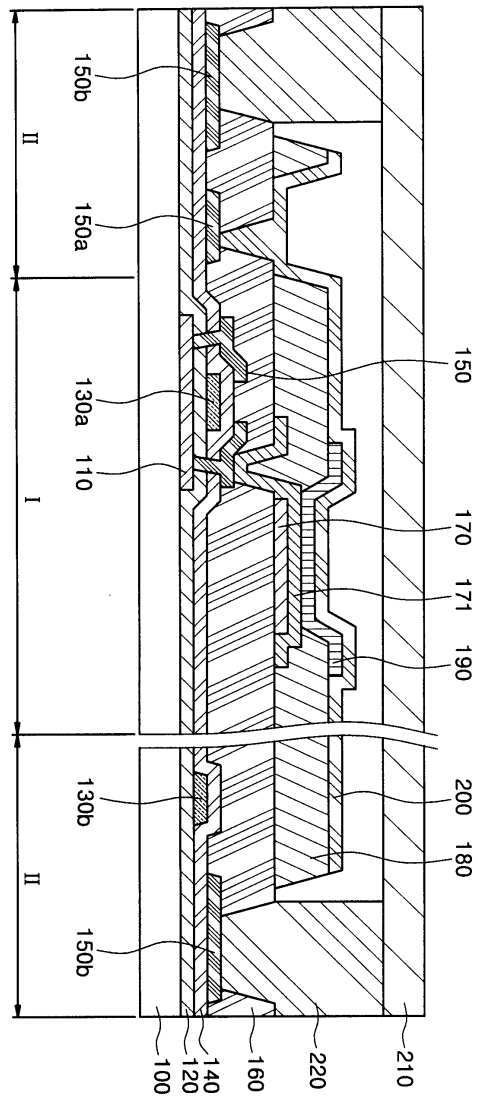
청구항 12.

제 8 항에 있어서,

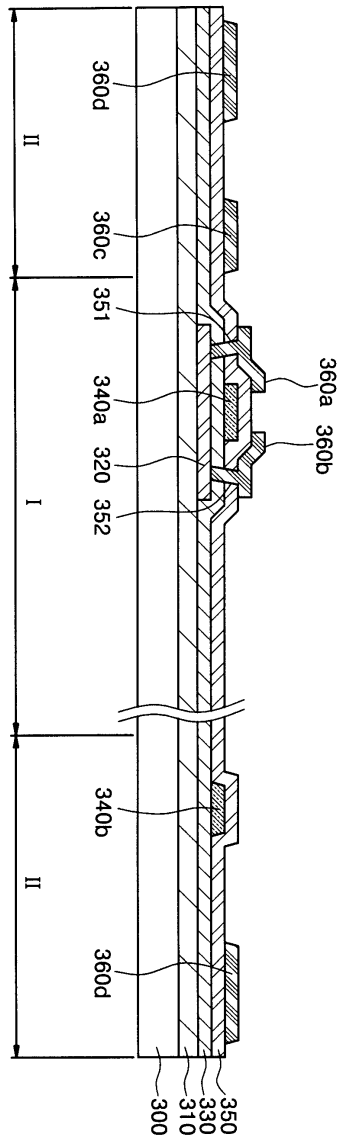
상기 글라스 프리트는 디스펜싱법 또는 스크린 인쇄법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제조방법.

도면

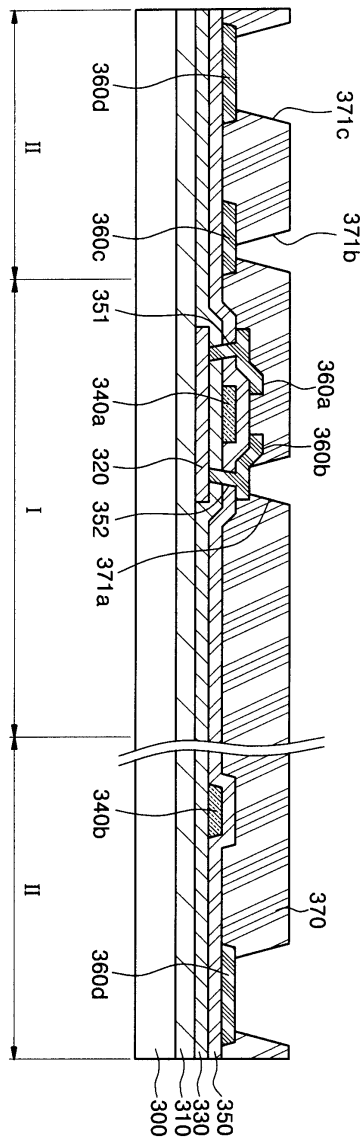
도면1



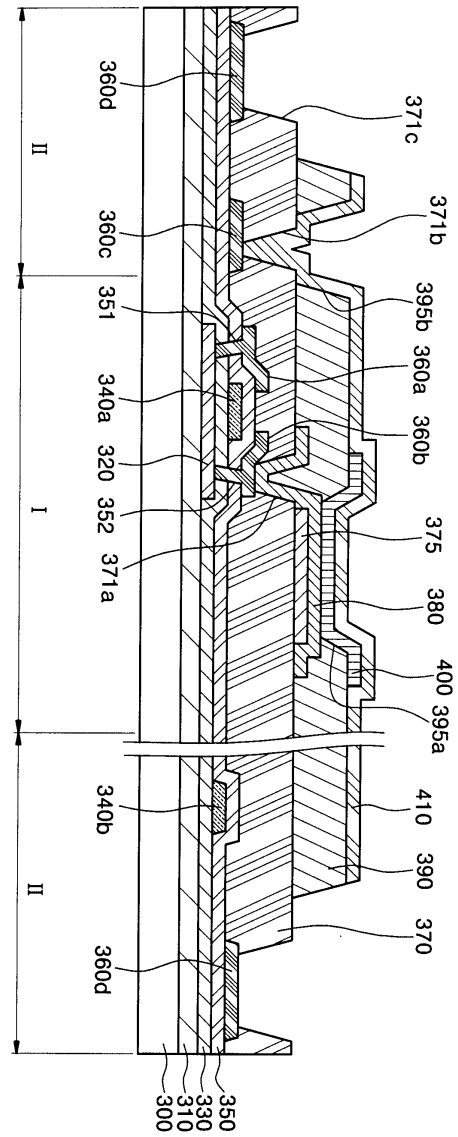
도면2



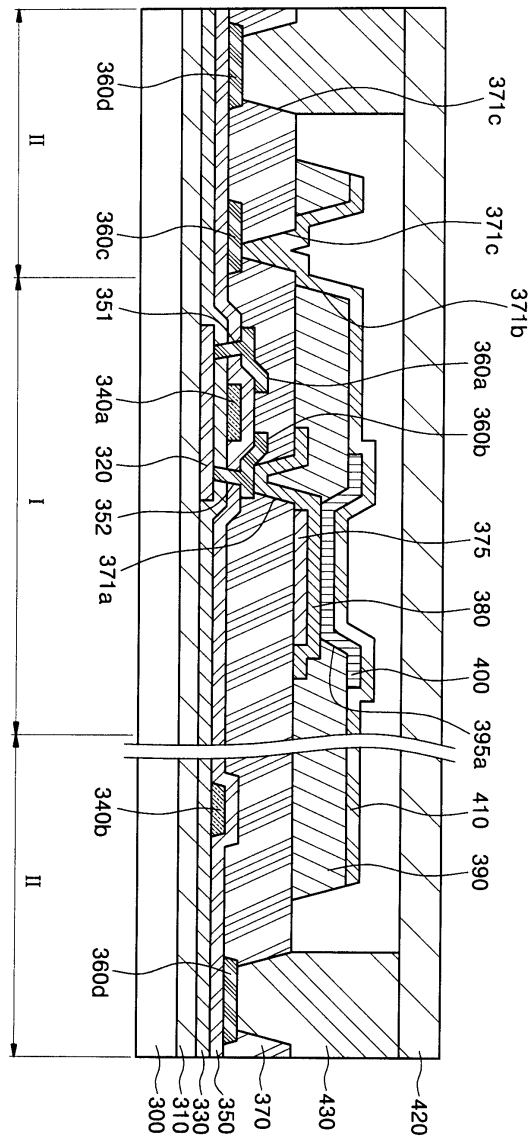
도면3



도면4



도면5



专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	KR100635514B1	公开(公告)日	2006-10-18
申请号	KR1020060007025	申请日	2006-01-23
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	CHOI DONG SOO 최동수 PARK JIN WOO 박진우		
发明人	최동수 박진우		
IPC分类号	H05B33/04 H05B33/10		
CPC分类号	H01L27/3276 H01L51/5237 H01L51/5246 A61M5/3221 A61M5/3232 A61M5/5066 A61M2005/3206 A61M2005/3231 A61M2005/5073		
代理人(译)	PARK, 常树		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示装置及其制造方法，其能够防止激光过热时装置的损坏，激光在焊接基板的玻璃料中照射。本发明包括基板，包括薄膜晶体管，包括半导体层，栅电极和源/漏电极，薄膜晶体管，第一电极位于有机平坦化膜上：有机平面化膜位于表面，像素定义位于第一电极上的层和位于有机膜上的第二电极：有机膜至少表示发光层，它位于第一电极和像素限定层的表面上，非像素区域称为区域，包括像素区域像素区域和密封机板焊接基板。并且，非像素区域包括包括金属线的有机平坦化膜，以及暴露金属线的一部分的开口部分和位于开口部分的表面上的玻璃料，并用于焊接基板和密封机板。玻璃料和有机电致发光显示装置。

